

Сведения об оппоненте

по диссертации Лайпанова Мурата Занарусумовича на тему «Контактное плавление и фазообразование макро-, микроразмерных систем медь-алюминий, никель-алюминий, никель-олова», представленной на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 01.04.07 – Физика конденсированного состояния

Фамилия Имя Отчество оппонента	Хасанов Асламбек Идрисович
Шифр и наименование специальностей, по которым защищена диссертация	01.04.14. – Теплофизика и теоретическая теплотехника
Ученая степень и отрасль науки	Кандидат физико-математических наук, 01.04.14. – Теплофизика и теоретическая теплотехника
Ученое звание	Доцент
Полное наименование организации, являющейся основным местом работы оппонента	ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет»
Занимаемая должность	Заведующий кафедрой «Физическая электроника»
Почтовый индекс, адрес	364093, Северо-Кавказский федеральный округ, Чеченская Республика, г. Грозный, ул. Шерипова, 32
Телефон	8-928-018-96-48
Адрес электронной почты	aslan2001@rambler.ru

Список основных публикаций официального оппонента по теме диссертации в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет (не более 15 публикаций):

1. Хасанов А. И., Мустафаев Г. А., Мустафаев А. Г. / Особенности гидрогенизации поликремниевых тонкопленочных транзисторных структур в плазменном разряде // Вестник Академии наук Чеченской Республики. – Грозный, 2016. – № 1 (30). – С. 37–38.
2. Хасанов А. И., Хасанов И., Элимханов Д. З., Авторханов У. А. Вакуумный насос. Пат. 163938. Заявитель и патентообладатель: ФГБОУ ВО «Чеченский

государственный университет» - 2015140459/06, 22.09.2015 опубл. 20.08.2016 Бюл. № 23.

3. Хасанов А. И., Мустафаев Г. А., Панченко В. А., Мустафаев А. Г., Калинина Н. В. / Моделирование параметров границы раздела графен – гексагональный нитрид бора // Вестник Академии наук Чеченской республики, Грозный, 2017, №1, С 22-27.
4. Хасанов А. И., Мустафаев Г. А., Мустафаев А. Г., Черкесова Н. В. / Влияние ионизирующих излучений и температуры на радиационную стойкость полупроводниковых приборов // Известия ЧГУ, Грозный, 2017, №4, С 29-32.
5. Хасанов А. И., Мустафаев Г. А., Мустафаев А. Г., Черкесова Н. В. / Применение силицида вольфрама как токопроводящего материала для металлизации // Известия ЧГУ, Грозный, 2017, №4, С 36-40.
6. Хасанов А. И., Мустафаев Г. А., Панченко В. А., Мустафаев А. Г., Калинина Н. В. / Оптические свойства многослойной гетероструктуры на основе широкозонных полупроводников ALN/GAN // Вестник Академии наук Чеченской республики, Грозный, 2018, №1, С 30-34.
7. Хасанов А. И., Мустафаев Г. А., Панченко В. А., Мустафаев А. Г., Калинина Н. В. / Расчет энергетической диаграммы многобарьерной полупроводниковой гетероструктуры // Вестник Академии наук Чеченской республики, Грозный, 2018, №6, С 43-47.
8. A. I. Khasanov, A. M. Bagov, T. Kh. Tamaev, R. T. Uspazhiev, A. M. Gachaev, M. A. V. Zubkhadzhiev / Phase Formation in Contacting Zinc Melting with Indium and Stannic in the Presence of Strontium Impurity and Microhardness of Derived Alloys // International Symposium «Engineering and Earth Sciences: Applied and Fundamental Research» (ISEES 2018). Advances in Engineering Research, Volume 177, P. 143-145.
9. A. I. Khasanov, G. A. Mustafaev. A. G. Mustafaev. N. V. Cherkesova / Thin Layers of Oxide Coating in Very-Large-Scale Integration // International Symposium «Engineering and Earth Sciences: Applied and Fundamental Research» (ISEES 2018). Advances in Engineering Research, Volume 177, P. 397-399.
10. A. I. Khasanov, A. M. Bagov, T. Kh. Tamaev, Zubkhadzhiev / Influence of Electric Transfer on Mutual Diffusion and Macroscopic Flow in Binary Melts Growing During Contact Melting // International Symposium "Engineering and Earth Sciences: Applied and Fundamental Research" (ISEES 2019). Atlantis Highlights in Material Sciences and Technology (AHMST), volume 1, P. 153-158.
11. A. I. Khasanov, G. A. Mustafaev. A. G. Mustafaev. N. V. Cherkesova / Electrostatic Charges and Ion Implantation Impact on the MIS Transistors Parameters Degradation // International Symposium "Engineering and Earth Sciences: Applied

and Fundamental Research" (ISEES 2019). Atlantis Highlights in Material Sciences and Technology (AHMST), volume 1, P. 787-790.

12. A. I. Khasanov, G. A. Mustafaev. A. G. Mustafaev. N. V. Cherkesova / Impact of Defects Caused by Hot Charge Carriers on the Digital VLSI Parameters // International Symposium "Engineering and Earth Sciences: Applied and Fundamental Research" (ISEES 2019). Atlantis Highlights in Material Sciences and Technology (AHMST), volume 1, P. 791-794.

Хасанов А. И.



Личную подпись Касанова
Алишера Ширванчи
заверяю. Начальник отдела кадров персонала
Душар Душар
(подпись) (расшифровка)

